

### 产品介绍

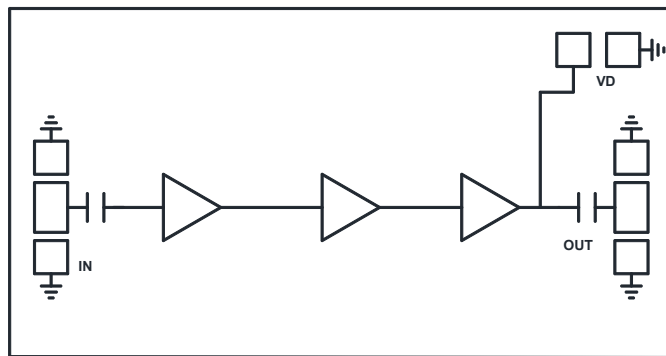
YLN208-0822T1 是一款性能优良的超宽带高线性低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 8~22GHz，小信号增益典型值 25dB，噪声系数典型值 1.2dB，输出 1dB 压缩功率典型值 6.5dBm，饱和输出功率典型值 8.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 频率范围：8-22GHz
- 小信号增益：25dB
- 噪声系数：1.2dB
- 输出1dB压缩功率：6.5dBm
- 饱和输出功率：8.5dBm
- 输出三阶交调功率：16dBm
- 输入回波损耗：20dB
- 输出回波损耗：18dB
- 供电：14mA@+5V
- 芯片尺寸：2.00mm×1.05mm×0.10mm

### 功能框图

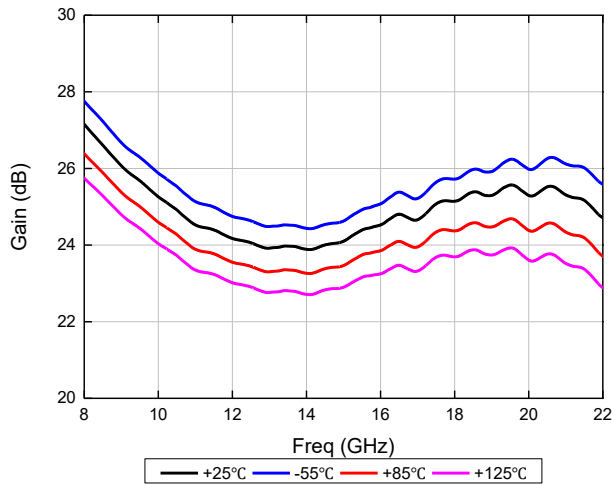
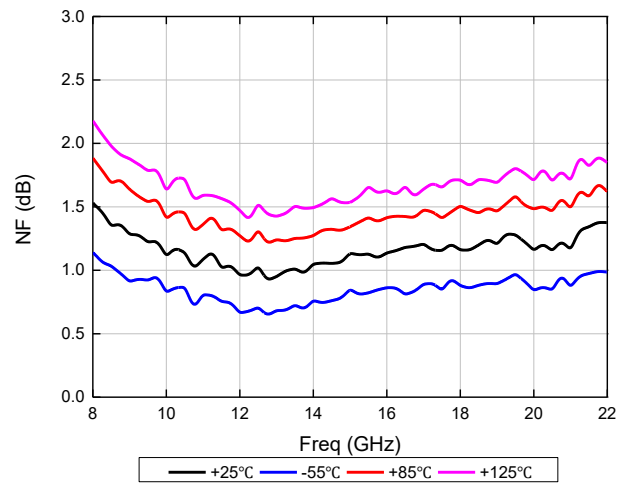
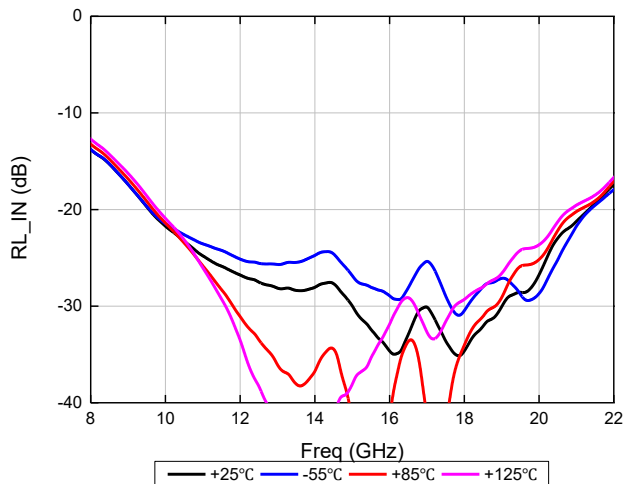
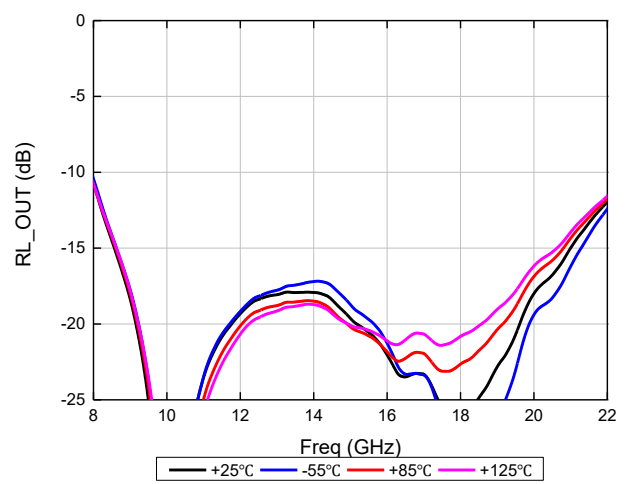
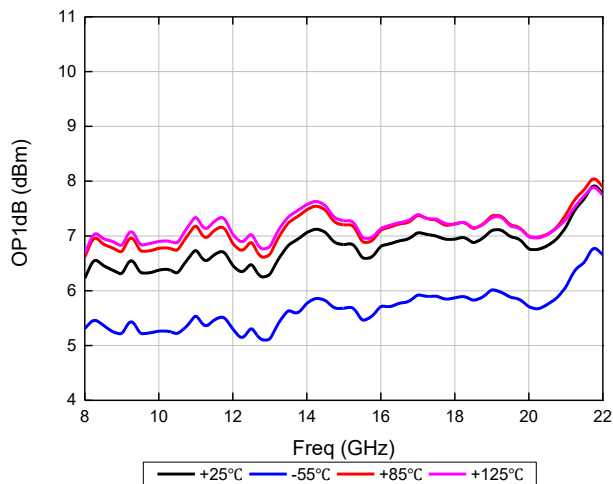
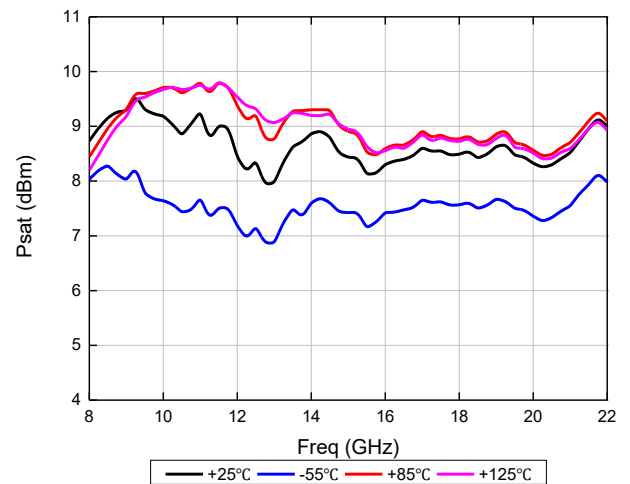


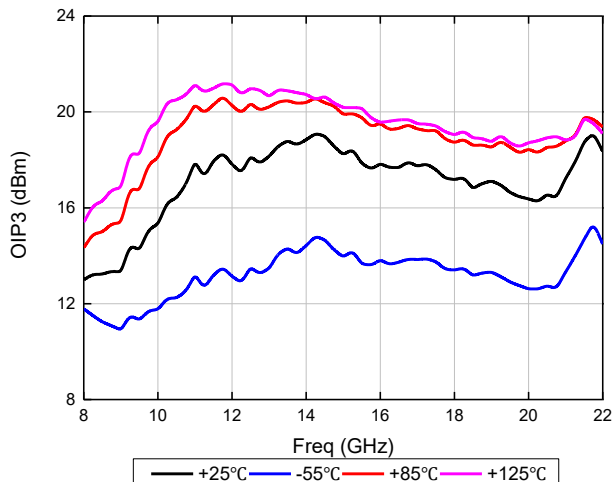
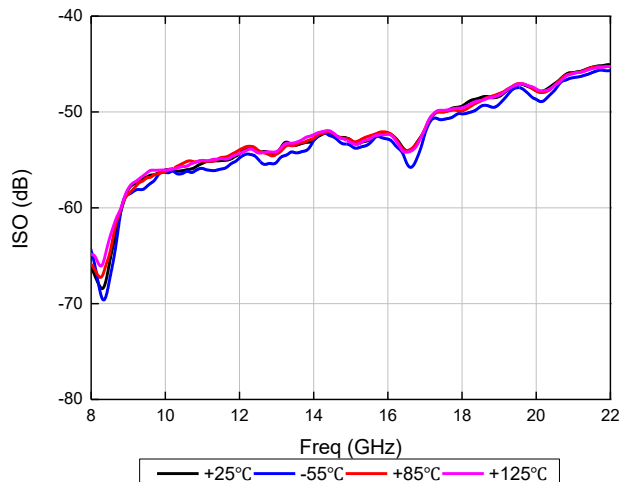
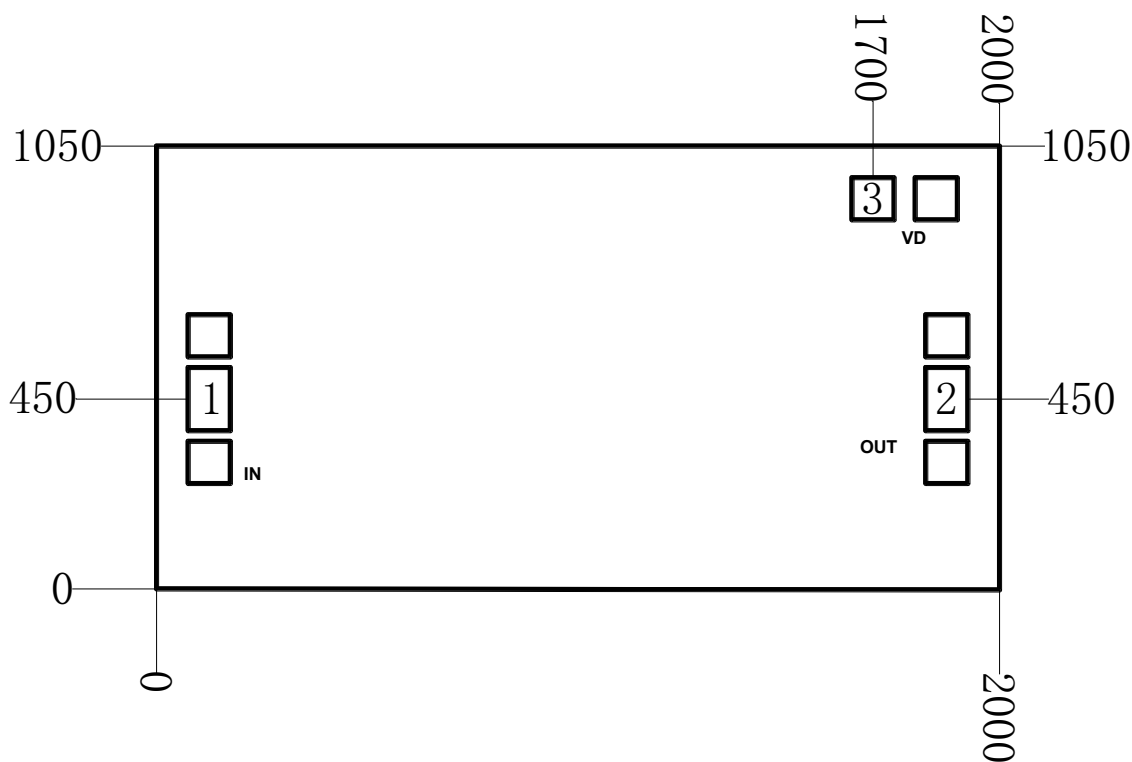
### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C, V<sub>D</sub>=+5V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	8	—	22	GHz
小信号增益	Gain	23.5	25	—	dB
噪声系数	NF	—	1.2	1.5	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	5.5	6.5	—	dBm
饱和输出功率	Psat	7	8.5	—	dBm
输出三阶交调功率	OIP3	12	16	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	12	20	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	10	18	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	14	—	mA

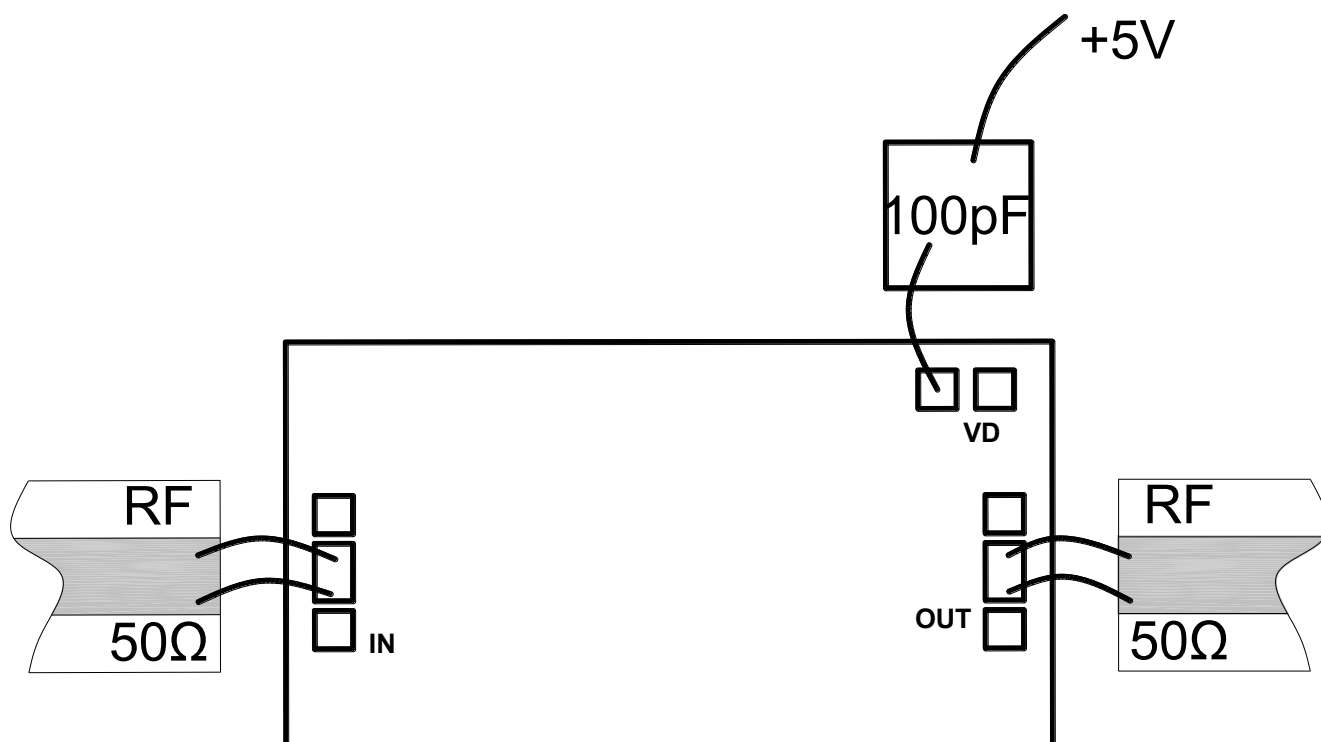
### 使用限制参数

最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

**测试曲线 (VD=+5V)**
**小信号增益**

**噪声系数**

**输入回波损耗**

**输出回波损耗**

**输出1dB压缩功率**

**饱和输出功率**


**输出三阶交调功率 (Pin=-25dBm/tone)**

**反向隔离度**

**芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )**

**端口定义**

端口编号	端口尺寸	功能符号	功能描述
1	150um×100um	IN	射频信号输入端, 外接 50 欧姆系统
2	150um×100um	OUT	射频信号输出端, 外接 50 欧姆系统
3	100um×100um	VD	漏极电压馈电端, +5V
其它	100um×100um	GND	供探针测试用的接地压点

**建议装配图**

**注意事项**

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 $\mu$ m 金丝），键合线尽量短，不要长于 300 $\mu$ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。